物理学报 Acta Physica Sinica

Chinese Physical Society
 Institute of Physics, CAS

铁电体的光伏效应

蔡田怡 雎胜

Photovoltaic effect in ferroelectrics

Cai Tian-Yi Ju Sheng

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 67, 157801 (2018) DOI: 10.7498/aps.67.20180979 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20180979 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2018/V67/I15

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

Cu₂O/ZnO 氧化物异质结太阳电池的研究进展

Progress of Cu₂O/ZnO oxide heterojunction solar cells 物理学报.2018, 67(11): 118401 http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20172037

湿度环境下钙钛矿太阳能电池薄膜微结构演化的同步辐射原位实时研究

An in-situ real time study of the perovskite film micro-structural evolution in a humid environment by using synchrotron based characterization technique 物理学报.2017, 66(1): 018401 http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.018401

ZnO电子传输层对于反型结构聚合物太阳电池光浴效应的影响

Effect of ZnO electron-transport layer on light-soaking issue in inverted polymer solar cells 物理学报.2015, 64(8): 088401 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.088401

高效率钙钛矿太阳电池发展中的关键问题

Key issues in highly efficient perovskite solar cells 物理学报.2015, 64(3): 038404 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.038404

有机无机杂化固态太阳能电池的研究进展

Recent progress in research on solid organic-inorganic hybrid solar cells 物理学报.2015, 64(3): 038405 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.038405

多铁性: 物理、材料及器件专题

铁电体的光伏效应^{*}

蔡田怡† 雎胜‡

(苏州大学物理科学与技术学院,苏州 215006)

(2018年5月18日收到; 2018年6月13日收到修改稿)

介绍了铁电光伏效应的发展历史和现状,通过与传统半导体 p-n 结光伏器件比较,旨在阐述铁电光伏器 件非比寻常的优点和重要的应用前景.铁电光伏效应分为体光伏效应和反常光伏效应,多种物理机制已被发 现,无疑为铁电光伏效应的提高指明了方向.还对钙钛矿氧化物、卤化物和双钙钛矿结构氧化物等铁电体中的 光伏效应进行了阐述,讨论了通过引入新的自由度实现多功能性光伏器件的可能性.

关键词:铁电体,光伏效应,多铁性材料,太阳能电池 PACS: 78.56.-a, 84.60.Jt, 77.84.-s, 75.85.+t

DOI: 10.7498/aps.67.20180979

1引言

在现代经济迅速发展的驱动下,世界各国对能 源的需求与日俱增,已成为世界经济可持续快速发 展所面临的重大难题. 在这一形势下, 推进能源生 产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体 系已成为我国近期的重要发展目标之一. 开发和利 用清洁、可再生的太阳能是解决问题和实现目标的 重要思路. 太阳能光伏电池的研究和设计也因此吸 引了众多国内外研究者的广泛关注,其原理是利用 光伏效应将太阳的光能转换为电能^[1].目前,基于 无机或有机半导体材料的光伏电池已经得到大量 的研究,其中硅型光伏电池开发最早^[2]、技术也最 为成熟,已得到规模化生产,但其光电转换机制决 定其转换效率不能突破Shockley-Queisser极限^[3]. 虽然近来提出可以通过电池叠装等复杂的制造工 艺提高光电转换效率,但毫无疑问造价不菲^[4-6]. 因此,寻找新型的光伏材料以研制性能更优良、功 能更丰富的太阳能电池已成为目前这一领域的研 究热点.

40年前, Fridkin^[7]提出可以利用铁电体实现 光电能量转换,他甚至指出基于所谓的"光铁电晶 体"能够制备太阳能电池.但在后来的研究工作中, 以铁电体为基础的光伏器件研究大多仅仅局限于 纯粹的学术领域,工业上的实际应用受到低量子效 率以及低导电能力的限制.在理论上,铁电性的起 源也并不清晰,直到现代铁电极化理论的建立^[8], 这一问题才得到明确的认识.近年来,很多令人兴 奋的突破性成果在铁电体中被发现^[9,10],包括高于 能隙的光生电压、低能隙铁电体的发现和高光电转 换效率,激发了众多研究者对铁电体光伏器件的研 究热情.

需要注意的是,电子有电荷、晶格和自旋等多 个自由度,自由度间相互作用、相互耦合,使铁电 极化强度的量值和方向容易受到物理、化学和力学 等多种外加手段的调控,使铁电体具有丰富的功能 性和非比寻常的应用前景.例如,铁电体已经被用 于制备记忆存储介质^[11,12]、铁电场效应管和铁电 随机存储器^[13,14]等.铁电性和力学参量的耦合使 铁电体还被设计应用于多种传感器中.最为重要的

^{*} 国家自然科学基金(批准号: 11374220, 11104193)、国家重点基础研究发展计划(批准号: 2014CB920900)、江苏省青蓝工程和苏州 大学东吴学者计划资助的课题.

[†]通信作者. E-mail: caitianyi@suda.edu.cn

[‡]通信作者. E-mail: jusheng@suda.edu.cn

^{© 2018} 中国物理学会 Chinese Physical Society

是,在一类"特殊"铁电体即多铁性材料中,还存在 着活跃的磁性序参量,它与铁电序参量间存在着耦 合作用,从而表现出丰富的磁电效应^[15-18],例如, 锰氧化物中的庞磁电阻、铁磁性和电荷序的共存以 及巨磁介电效应等.这使多铁性材料从出现伊始就 得到自旋电子学、磁电子学和光电子学等多个领域 研究者的广泛关注^[19-22].

本文以传统半导体中的光伏效应为出发点,介 绍铁电体光伏效应的主要机制,包括体光伏效应和 反常光伏效应,讨论铁电体在太阳能电池中的可能 应用,探索增强光伏效应的方法,为铁电光伏效应 引入新的自由度和新的调控手段.

2 传统光伏效应

当半导体吸收高于本征能隙能量的光子时,价 带顶的电子将被激发跃迁至导带,产生电子和空穴 载流子.这些被激发的载流子将很快衰减至基态, 并通过发射光子或声子保持能量守恒.但是,当半 导体中的静电势具有不对称结构(内建电场)时,可 能将电子载流子和空穴载流子分离,向相反方向



运动,从而出现光生净电子流或空穴流,即光电流. 显然,光伏效应依赖于两个基本过程:首先是光生 载流子的产生,这可以通过半导体吸收光实现;其 次是在内建电场下光生电子和空穴被分离和收集, 形成向特定方向流动的净电流.当人们认识到半导 体对光的吸收能力后,后者成为设计制造太阳能电 池的关键.

在太阳能电池的早期实验中,研究者曾在两个 不同金属电极间插入硒薄层,形成肖特基势垒结 构,不同金属电极间的功函数差异使金属-半导体 接触界面附近的静电势不再对称,导致整流效应的 出现.在1950年左右,研究者又设计出另一种结 构以分离光生电荷.通过在硅薄膜的两端区域分 别掺杂磷元素和硼元素,形成p-n结.如图1(a)所 示,p-n结中的内建电场使光激发的电子空穴对被 迅速分离,导致更为显著的光伏效应^[23].传统光伏 器件中,内建电场通常是依靠光伏器件结构中材料 之间的显著差别在界面及其附近实现的,如p-n同 质结、p-n异质结(例如CdS/CdTe 薄膜电池)以及 p-i-n结等.



图 1 产生光伏效应的示意图^[23] (a) 半导体 p-n 结; (b) 铁电光伏效应 Fig. 1. The photoelectric effect in (a) the semiconductor p-n junction and (b) the ferroelectrics^[23].

通过与理想光伏器件功率进行对比,可以容易 地得到光电转换效率 (power conversion efficiency, PCE)的一般定义. 若入射光的功率为 $P_{\rm in}$,则光电 能量转换效率 η 正比于开路电压 $V_{\rm oc}$,短路电流 $J_{\rm sc}$ 和填充因子FF表示为

$$\eta = \frac{V_{\rm oc} J_{\rm sc} FF}{P_{\rm in}}.$$
 (1)

如图 2 所示, 开路电压 V_{oc} 和短路电流 J_{sc} 分别是光 伏器件在理想条件下光生电压和光电流的最大值, 理想太阳能电池产生的功率可以表示二者的乘积 P_{max}.由于载流子间的复合不可避免地带来能量 的损失, 实际器件在 J-V 曲线上所能得到的最大功 率总是低于理想功率,它们的比值被称为填充因子 (FF).显然,为了得到高光电转换效率的光伏器件, 不仅要求具备良好的可见光吸收率和量子效率(输 出电流),同时要求足够强的内建电场(输出电压). 在传统的半导体光伏器件中,半导体对太阳光谱的 吸收能力决定 J_{sc}值的大小,而V_{oc}的值受半导体的 能隙所限制.另一方面,被光激发的热载流子通过 非弹性散射弛豫至导带底,这一过程中能量的损失 必然会导致 PCE 的降低.另外,为了得到较高的光 电流,传统的半导体 p-n 结光伏器件对半导体/金属 界面和制备薄膜技术均要求较高.



图 2 太阳能电池的短路电流 J_{sc} 、开路电压 V_{oc} 和理想功 率 P_{max} ^[24]

Fig. 2. Schematic of solar cell output current as a function of voltage, for a shift current solar cell, displaying the linear relationship between current and voltage. Also shown are short-circuit current $J_{\rm sc}$ and open-circuit voltage $V_{\rm oc}$ points, and maximum power point, $P_{\rm max}$ [24].

3 铁电光伏效应

为了突破光生电压的这一限制,研究者开始寻 找产生内建电场的新机制,铁电体因为其具有高自 发铁电极化强度而进入研究者的视野.研究者猜测 铁电体中的铁电极化可以扮演"内建电场"的角色, 迅速分离光生载流子向不同方向运动,并且这一相 对较强的电场还将有效地降低载流子间的复合率, 提高光电转换效率(图1(b))^[23].实验上也证实,利 用铁电体制备的太阳能电池可以得到较高的开路 电压(Voc),并不受材料的本征能隙限制,在这一点 上,明显优于 p-n结半导体光伏器件.

目前, 对铁电光伏材料和器件的研究包含以下 独立的方向. 随着单原子层可控的现代沉积技术 的发展和现代铁电极化理论的建立, 研究者试图 从基础物理和材料设计的角度, 探讨铁电氧化物 中光伏效应的机制, 寻找提高光电转换效率的新 途径, BiFeO₃ 成为这一方向上最受青睐的研究对 象^[25-29]; 受到发现高光电转换效率的鼓舞, 越来 越多的研究者将目光投向有机-无机杂化卤化物钙 钛矿材料^[30-36], 尤其是 CH₃NH₃PbI₃, 这无疑引 领着太阳能研究领域新的发展趋势; 还有些研究者 进一步挖掘铁电光伏器件潜在的多功能性, 在铁电 体中, 新的自由度 (自旋自由度) 被引入, 光伏效应 可被电场、磁场等多种外加手段所调控.

3.1 铁电光伏效应的唯象理论^[37]

在短路条件下,光照使无对称中心的均匀介 质产生稳态光电流 *j*_{pv},并且 *j*_{pv} 的值与光的极化相 关.在开路条件下,这一结构可作为电流源,产生 光电压,

$$U_{\rm pv} = \frac{j_{\rm pv}l}{\sigma_{\rm d} + \sigma_{\rm pv}},\tag{2}$$

其中 σ_d 和 σ_{pv} 分别是暗电导和光电导, *l*是电极之间的距离. 当 $\sigma_{pv} \gg \sigma_d$ 时, 光伏效应产生的光生电场可以简化为

$$E_{\rm pv} = \frac{J_{\rm pv}}{\sigma_{\rm pv}},\tag{3}$$

其中 $\sigma_{pv} = eI_0\alpha\varphi(\hbar\omega)^{-1}(\mu\tau)_{pv}$. 这里 μ_{pv} 和 τ_{pv} 分 别是非平衡载流子的迁移率和寿命. I_0 是入射光的 强度, α 是吸收系数, $\hbar\omega$ 是光子能量, φ 用来描述量 子特征, e是电子电荷. 当 σ_{pv} 足够小(大部分铁电 体都是如此), 晶体中的光电压可能超过能隙宽度 几个数量级.

光电流的张量性质可以用下式表示:

$$J^{i}_{\rm pv} = \alpha e_j e_l G_{ijl} I_{\rm o}, \qquad (4)$$

式中, $e_j 和 e_l$ 是描述光极化的矢量分量; G_{ijl} 是三 阶压电张量, $G = el_0 \zeta \varphi(\hbar \omega)^{-1}$, 其中参数 ζ 用来描 述激发的反对称性. 简单地, 可以得到如下的标量 关系:

$$\dot{i}_{\rm pv} = \alpha G I_0, \tag{5}$$

$$E_{\rm pv} = \frac{G}{\varphi(\mu\tau)_{\rm pv}} \frac{\hbar\omega}{e}.$$
 (6)

单位面积铁电体的光电转换效率可以被定义 为负载消耗的功率 $Q_{\rm R}$ 和吸收光的功率 $Q_{\rm pv}$ 的比 值,其中 $Q_{\rm R} = j_{\rm pv}^2 R$, $R = \sigma_{\rm pv}^{-1} l$, $\sigma_{\rm pv}^{-1} \sim (\mu \tau)_{\rm pv}^{-1}$, 而 $Q_{\rm pv} = \alpha I_0 l$,因此,

$$\eta = \frac{Q_{\rm R}}{Q_{\rm pv}} = \frac{j_{\rm pv}^2}{\alpha I_0(\mu\tau)_{\rm pv}}.$$
(7)

考虑到(5)式,光电转换效率进一步简化为 $\eta = GE_{pv}$.目前,实验上已经对大部分常见铁电体和压电体的 $G 和 E_{pv}$ 进行测量^[38,39].以BaTiO₃ 块材(C_{4v} 对称性)为例,实验发现 $G_{31} \sim (3-6) \times 10^{-9}$ cm/V, $E_{p} \sim 10^{2}$ V/cm,可以估计 $\eta \sim 10^{-7}$ ^[38,40],显然这是个极低的值.但是,当铁电晶体的厚度减小到纳米尺度,即l与基态载流子的位移相比拟或者较小时,光生电场和光电效率会显著增强.当 $l \approx l_0$ 时,所有光生载流子均不是热载流子,都对光电流有贡献,此时光电流达到最大值. l_0 的值由反对称参数 ζ 和光激发的能量决定.基于固体能带理论的估算表明 l_0 的范围在10—100 nm之间^[38],这暗示着铁电光伏器件在纳米尺度的应用前景.

3.2 体光伏效应

未掺杂单晶样品中的光伏效应被称为体光 伏效应. 最早关于体光伏效应的报道出现于 1956年^[41],对BaTiO₃单晶样品的光电流测量结 果表明,光电流的值与样品的宏观电极化强度和方 向密切相关. 类似的实验结果在其他具有非对称中 心的材料中也被发现,例如LiNbO₃,LiTaO₃以及 被广泛关注的BiFeO₃.

最早试图解释体光伏效应的理论模型认为铁 电体中可能存在反对称的散射中心^[42].如图3(a) 所示,铁电体中随机分布着一些取向一致的楔形散 射中心.即使仅存在载流子的随机扩散和漂移,铁 电体内也会出现净电流.但是,由于熵增原理的限 制,基于这一机制产生的电流在实空间上是局域 的,并且不能持久.

另一个理论模型则基于静电势的不对称[43],

图3(b)显示电子和空穴的扩散过程,此时吸收中 心的势具有明显的各向异性(可由电极化导致). 当 载流子吸收光子从 E_0 态被激发至E态, 若 $E < V_1$ 则被激发的电子将陷落在势阱中,只有能量较 高 $(E \gg V_2)$ 的载流子才能各向同性地离开势阱 的束缚. 对于能量处于势阱高度之间的载流子 $(V_1 < E < V_2)$,向左的运动将被散射势垒部分散 射,从而在整体上出现方向向右的净电流.正如上 文所讨论的,基于这一机制产生的电流对整个光电 流的贡献将在超薄膜中表现得最为明显,这是因 为晶体厚度减小至与光生载流子的衰减长度相当 $(l \approx l_0)$. 图4展示的是晶体中的这一弹道输运过 程,光照下,热载流子被激发,晶体中原有的细致平 衡被破坏. 当晶体中无对称中心时, 热光生载流子 在导带中存在着不对称的动量分布,当它们损失能 量,重新衰减至导带底时,在实空间内对应着特征 长度为l₀的位移^[37].



图 3 体光伏效应模型^[10], 当 (a) 楔形散射中心^[42]、(b) 不对称的势阱^[43]和 (c) 自旋轨道耦合作用^[44]存在时净电流的产生 Fig. 3. Models for the bulk photovoltaic effect^[10]: (a) Asymmetric carrier scattering centres, resulting in a net flow from randomly drifting carriers, following Belinicher^[42]; (b) asymmetric potential well at a carrier generation centre; photogenerated carriers have a preferred direction of exit, following Lines^[43]; (c) relativistic splitting of the conduction band minimum establishes two distinct channels for electron excitation, polarized light promotes electrons preferentially to one channel, following Fridkin^[44].

研究者认为当铁电体中存在较强的自旋-轨道 耦合时,体光伏效应有着不同的物理起源^[44].在 这一机制中,同样需要晶体反演对称性的破缺^[45]. 当自旋-轨道相互作用较弱时,所有的价带电子在 吸收足够的光子后被激发的概率相等.但如果自 旋-轨道耦合作用较强,在Rashba自旋轨道耦合作 用下,导带进一步劈裂(如图3(c)所示),光生载流 子的动量依赖于自旋,即不同极化的光照射将导致 净电流,例如顺时针极化的光将激发 $k_z > 0$ 的电 子,而逆时针极化的光将激发 $k_z < 0$ 的电子.由于 价带和导带由不同的轨道所贡献,因此电子和空穴 的自旋劈裂并不相同.当材料中含有重元素 (Pb或 Bi)时,自旋轨道耦合作用将变得更为重要,近年来 对CH₃NH₃PbI₃的研究正说明了这一点^[46,47].



图 4 与 (a) 有反演中心的晶体对比, (b) 无反演中心的晶体中 载流子具有非对称的动量分布, 并产生净电流^[37]

Fig. 4. (a) Isotropic and (b) anisotropic nonequilibrium carriers momentum distribution in centrosymmetric and noncentrosymmetric crystals corresponding to the classical and bulk photovoltaic effects, respectively ^[37].

以上的三个物理模型虽然描述不同,但本质上 都认为净光电流的产生是由于晶格势中运动的光 生载流子具有不对称的速率(动量)导致.近来,有 观点指出, 净光电流的产生还可能与不对称的电子 密度相关.载流子在能量空间里的激发,也伴随着 实空间里的"虚"位移,即位移电流模型.事实上, 位移电流导致的体光伏效应已经在铁电体 [48-51]、 量子阱^[52]、有机晶体^[53]和两维界面^[54]等多种体 系中发现. von Baltz和Kraut^[55]首先提出用位移 电流模型解释BaTiO3中的体光伏效应,在理论 上很快用格林函数方法^[56],在非线性光学的理论 框架^[57]下推导出位移电流的表达式. Young和 Rappe^[26] 重新推导位移电流的表达式, 使其可被 用于第一性原理计算,并首次将计算得到的位移电 流的值直接与实验结果相比较. 在后来的第一性原 理相关工作中, 位移电流被认为是铁电体体光伏效 应的主要贡献^[24,58-62].

3.3 反常光伏效应

正如前文所描述,在传统的半导体器件中,能 够获得的光电压一般被光吸收材料的能隙所限. 但是,1946年Starkiewicz等^[63]在PbS薄膜上的实 验结果却首次打破了这一规则.紧接着,类似的 实验结果也在CdTe,ZnTe和InP多晶样品中被报 道^[64-66].而对大量铁电薄膜光伏效应的研究表 明,导致光伏性能提高的因素纷繁复杂,薄膜的铁 电性能^[67-70]、界面的结构和状态^[70-74]、薄膜厚 度、晶粒和电畴尺寸等尺度效应^[67]以及空间电荷 效应^[69]等,都会对铁电薄膜的光伏性能有明显的 影响.在已有的实验结果中,上百倍甚至上千倍于 材料本征能隙的光电压被发现,光电流也得到提 高,但光伏性能的改善敏感于样品的制备条件,因 此实验结果很难被重复.目前还无法用统一的模型 解释以上所有的实验现象,但研究者普遍认为这些 显著的光伏效应,并不是材料本身所具有的,而更 多地与材料的纳米或微米结构相关,区别于体光伏 效应,称之为反常光伏效应.并大致可以归结为以 下三种外禀因素.

1)铁电畴的畴壁.在铁电体中,光生载流子的 分离由材料自身的电极化强度所驱动,畴与畴间产 生电场.如图5所示,Yang等^[25]在研究BiFeO₃薄 膜光伏效应时发现,BiFeO₃中的光生电压随着极 化方向上畴壁数量的增加线性增加.而垂直于极化 方向上则没有观察到明显的光伏效应.简单估算可 以发现,垂直于畴壁方向的电极化强度分量在畴壁 处产生约10 mV的电压,畴壁宽度约为2 nm,因此 电极化在畴壁处产生的电场高达5×10⁶ V/m,远 大于传统半导体 p-n 结中的内建电场,可以驱动光 生载流子的分离,产生反常光伏效应.由于铁电体



图 5 与畴壁相关的反常铁电光伏效应^[25] (a) 电极方向垂直于畴壁, (b) 平行于畴壁; (c), (d) 分别是图 (a) 和 (b) 中相应 的 *I-V* 曲线

Fig. 5. Schematics of the anomalous photovoltaic effect with (a) electrodes perpendicular to the domain wall and (b) electrodes parallel to the domain wall. The corresponding photocurrent-voltage curve for the devices in (a) and (b) are shown in (c) and (d), respectively ^[25].

中电畴数目很多,在电场的作用下,被电极化的畴 首尾相连, 畴壁如同一个个串联起来的纳米尺度的 微电池.若这些铁电畴壁用串联的方式叠加起来, 光生电压也可以沿着电极化方向逐渐累加,输出电 压是每一个单元的和.当电极间距离越大,铁电畴 壁越多,光照下产生的光生电压也就越高,这一模 型可以很好地解释反常光伏效应.

2) 肖特基结. 当铁电体和金属电极相互接触 时,界面处的能带将会发生弯曲,即肖特基势垒. 起源于能带弯曲的内建电场可能驱动光生电子-空 穴对的分离,产生光电流.显然,光电流强度主要 由肖特基势垒的高度和电极附近耗尽层的宽度决 定^[72,75]. 与传统半导体太阳能电池类似, 这一机 制所产生的光生电压仍然受到铁电体本征能隙的 限制. 当采用不同电极构建铁电薄膜光伏器件时, 由于上下两个电极与铁电体构成的肖特基结并不 相同,产生的光生电压和电流不能相互抵消,这一 效应将变得格外重要,例如,已有实验报道,在具 有垂直结构的铁电光伏器件中光伏效应的增强可 以归结为这一机制的贡献^[76].另一方面,金属电 极和铁电体界面处的肖特基势垒高度与铁电体的 电极化强度相关,因此可以利用外加电场对肖特基 势垒的高度进行调控,从而影响光生电压[73].由 Au/BFO/Au构成的具有垂直结构的铁电二极管 中,光生电流及光生电压都随着电极化方向的变化 而变化[77].

3) 退极化场效应. 当铁电薄膜被极化时, 薄膜 表面具有高密度的极化电荷. 当铁电薄膜与金属 或半导体接触时, 剩余极化所引起的表面电荷被金 属或半导体中的自由电荷部分屏蔽, 铁电薄膜内仍 留下退极化场. 退极化场可能具有很大的值. 在 BaTiO₃ 薄膜(10—20 nm)中, 当采用SrTiO₃ 作为 电极, BaTiO₃ 中的退极化场高达45×10⁶ V/m^[78]. 显然, 这么强的退极化场可以驱动光生载流子的分 离. 退极化场的大小主要与铁电体的自发电极化强 度、介电常数、厚度和电极的介电常数相关^[74]. 越 强的退极化场将产生较高的光生电压.

为了避免结型器件中界面态的控制问题,还有的研究者另辟蹊径,直接采用铁电体-半导体耦合 方式构建器件^[79].如图6所示,分离光生载流子的 内建电场由电极化的纳米尺度电偶极子所形成的 极化电场提供,利用包裹电偶极子颗粒的半导体 吸光材料产生光生载流子.显然,在这一结构中, 光生载流子的产生和分离被区分在不同材料内进行. 电偶极子的作用仅是提供分离光生载流子的 电场,并不参与光吸收,也不必考虑载流子在其中 的输运问题.因此,纳米尺度电偶极子和半导体间 不需要很好的电接触,可以降低对界面态的控制要 求,在不削弱内建电场的同时,显著降低工艺难度 和成本.理论计算表明^[79],合理浓度的CdS纳米 颗粒可以产生均匀且足够强的宏观电场,电场达 到3×10⁴ V/cm,与理想 p-n结内建电场相当.目 前,实验上已在这一体系中获得超过8% 的转换效 率^[80].



图 6 偶极子极化产生的电场示意图^[79] Fig. 6. The electric field induced by the electric dipole^[79].

综上所述,铁电薄膜中的光伏效应可按照其起 源分为体光伏效应和反常光伏效应,并存在多种物 理机制.实验上测量得到的铁电体光伏效应可能来 自于多种机制的贡献.因此,实验工作者的困惑在 于如何区分体光伏效应和各种反常光伏效应的贡 献.值得庆幸的是,现代极化理论的发展使研究者 可以利用第一性原理方法计算各种不同机制对光 伏效应的贡献,计算得到的结果已能与实验初步符 合^[26].

4 钙钛矿结构氧化物

大部分铁电体都具有钙钛矿结构, 一般由三种 元素组成, 分子式可以表示为*ABO*3. *B*位阳离子 和氧离子形成*BO*6 八面体结构, 通过分享顶点原 子的方式形成三维空间结构. 高温时, 钙钛矿结构 的铁电体大多具有高对称性的晶体结构, 不表现出 铁电极化. 当温度降低, 晶体结构发生畸变, 转变 为对称性较低的相, 例如, 长方、正交、菱面结构, 并 具有铁电性或反铁电性. 由于钙钛矿结构氧化物铁 电体同时具有长程序和短程序, 它们的相图一般都 非常复杂^[81]. 大部分钙钛矿氧化物都是具有宽带 隙的绝缘体, 高温时以离子导电为主^[82,83]. 对于离 子型导电的氧化物,可以利用变价掺杂增加空位浓度而不是电子或空穴浓度.目前已有的实验结果表明基于钙钛矿氧化物的太阳能电池能量转换效率较低.例如基于体光伏效应的单晶BaTiO3太阳能电池,仅有10⁻⁷的极低能量转换效率[37].然而,近年来,通过减少层厚,优化畴壁结构和电极界面结构等方式,引入各种反常光伏效应,钙钛矿结构氧化物铁电体的光电能量转换效率得到显著提高[84].

阻碍钙钛矿氧化物铁电体实际应用的最主要 因素之一是宽能隙,至少3 eV的能隙宽度导致其 主要吸收波段在紫外区域. 由于紫外光对太阳光 谱的贡献仅为8%,因此目前在宽带隙铁电体中获 得的最高能量转换效率仅为1.25%,这一数值是在 PbZrTiO₃与窄带隙的非晶硅薄膜的复合结构中得 到的^[85].针对这一缺陷,已有研究者对钙钛矿结构 氧化物进行能带工程调控,使这些氧化物既保持良 好的铁电性质,又有合适的能隙进行光吸收,从而 提高光电转换效率 [86,87]. 例如, 相对于传统铁电材 料, BiFeO3的能隙减小为2.7 eV, 但仍保持有较大 的铁电极化,同时具有奇异的线性和非线性光学响 应^[88]以及光伏效应^[28,29,51,76,77,89-91].当用Cr替 换BiFeO3中的部分Fe时,所形成的双钙钛矿结构 Bi₂FeCrO₆光学带隙变化幅度可达几个eV,将能量 转换效率提高至8.1% [84].

5 钙钛矿结构卤化物

杂化钙钛矿卤化物以极高的光电能量转换效 率吸引着研究者以极大的热情投入到一个新的领 域. 自杂化钙钛矿卤化物首次作为光伏材料被报道 以来[30],非晶和薄膜结构的器件研究已经获得显 著进展[31-33,92-95],近来报道光电转换效率甚至已 经超过20%. 杂化钙钛矿卤化物的结构与钙钛矿氧 化物类似, 卤素原子取代氧离子, 导致阳离子价态 的平均值为+3. 以CH₃NH₃PbI₃为例,能带结构 计算表明,能量最高的价带由I5p带贡献,这导致 价带顶能量高于钙钛矿氧化物. Pb离子的自旋-轨 道耦合作用较强[96],导带的进一步劈裂使导带底 的能量也明显低于钙钛矿氧化物. 以上两种因素共 同作用导致钙钛矿卤化物的光学能隙远小于具有 同样结构的氧化物^[47,97],可见光区域吸收强度显 著增强^[98].同时,钙钛矿结构所特有的丰富的物理 和化学性质仍得到保留.

这类材料的另一个特别之处在于占据A位的 不再是无机离子,而是有机分子,毫无疑问,这将 引入额外的自由度.即使BX₆八面体形成的三维 结构仍可以导致铁电极化的出现,但晶体的对称性 被明显降低.已有研究表明,CH₃NH₃分子具有较 大的电偶极矩,对晶体的电极化强度以及优良的光 伏性能有重要的贡献^[99].A位有机分子的取向也 会导致材料结构的变化^[100].不仅如此,通过改变 有机分子的大小,卤化物的结构发生改变,能隙也 会随之得到调节^[98].例如,尺寸较大的阳离子导致 三维结构无法保持,断裂为二维层状结构^[101–103]. 仅当选取尺寸较小的离子作为阳离子时,三维结构 才是稳定的.

对钙钛矿结构卤化物器件的光伏性能研究发现, *J-V* 曲线表现出特殊的电滞行为^[104],离子扩散和铁电性被认为是导致这一异常现象的原因.目前不仅在实验上已经观测到铁电畴的存在^[105],第一性原理计算结果也表明这类材料具有较大的自发电极化强度,量值可与无机钙钛矿材料相比拟^[99]. *A*位有机分子电偶极矩的取向无序随着温度和应力的改变而变化,这无疑增加了这类材料的复杂程度.研究者还利用第一性原理方法对 CH₃NH₃PbI₃的位移电流进行计算,发现在可见光区域的显著体光伏效应是一般钙钛矿氧化物的三倍,并且这一效应明显依赖于*A*位有机分子电偶极矩的取向^[106].

6 自旋相关的铁电光伏效应

研究者不仅致力寻找具有高铁电极化强度、窄 带隙和高输出功率的极性半导体材料,还试图引入 新的自旋自由度,利用电场和磁场同时对光伏器件 进行调控,丰富光伏器件的多功能性,发展新型光 敏感多功能器件.双钙钛矿结构氧化物为这一方向 的研究提供了广阔的研究平台.

除了目前已受到广泛关注的Bi₂FeCrO₆以及 六角对称性的锰氧化物^[107]外,近年来,大量 LiNiO₃型铁电和多铁材料被成功合成,例如Zn-SnO₃^[108],ZnTiO₃^[109],PbNiO₃^[110],ScFeO₃^[111] 和Zn₂FeTaO₆^[112].LiNiO₃型结构是一种高畸变 钙钛矿结构,具有菱面体对称性,空间群类型为 R3c,当选取不同阳离子A位和B位时,相邻氧 八面体的反向旋转和阴阳离子的相对位移将改 变较大,并具有不同的铁电性和磁性质^[113–119]. ScFeO₃即是其中一种性质较为特别的材料, 它不 仅具有较高的铁电极化强度, 还具有弱铁磁性, 这在已经发现的多铁性材料中并不多见. 我们 选取ScFeO₃为母体材料, 用另一种磁性离子对*B* 位离子进行掺杂和替换, 试图在保持母体所具有 的高铁电极化强度的同时, 对能隙进行调控, 并 引入自旋自由度^[22]. 第一性原理计算结果表明, ScFe_{1-x}Cr_xO₃ (0.17 $\leq x \leq 0.83$)具有较高的铁电 自发极化强度 (100 μ C/cm²)、弱铁磁性 (磁化强度 约为170 emu/cm³)以及适中的带隙宽度 (1.8 eV). 由于 ScFe_{1-x}Cr_xO₃ 明显改善的可见光波段吸收, 我们预测这一材料将优于传统的钙钛矿氧化物 铁电体和多铁性材料, 甚至是目前广受青睐的有 机-无机杂化钙钛矿卤化物^[120](图7).



Fig. 7. Map of ferroelectric polarization and band gap of popular polar materials ^[22].

更为重要的是,考虑如图8(a)所示的具有不同自旋的光生载流子,ScFe_{1-x}Cr_xO₃的能带计算结果表明,吸光后产生的光生载流子具有百分之百的自旋极化率(图8(b)).显然,如果利用ScFe_{1-x}Cr_xO₃制备光伏器件,光电流也将是百分之百被自旋极化的,因此ScFe_{1-x}Cr_xO₃可能被应用于光自旋电子学的器件中,实现显著的多功能性.如图9(a)所示,我们基于ScFe_{1-x}Cr_xO₃进一步设计具有典型三明治结构的太阳能电池,模型计算发现不同的电极化方向会导致太阳能电池内静电势的分布发生变化(图9(b)),从而导致具有显著差异的整流行为(图9(c)).图9(d)表明仅考虑反常光伏效应,在这一体系中计算得到其能量转换效率高达9.0%.可以预期,如果再叠加上体光伏效应的贡献,基于ScFe_{1-x}Cr_xO₃的光伏器件将具有显

著的优势.另一方面,计算表明基于这一太阳能电 池的输运行为表现出明显的自旋极化的特征,几乎 在整个可见光光谱范围内产生的光电流都是100% 自旋极化的,这为该类型的光伏器件在光伏产业和 自旋电子学领域的应用开辟了新的途径,例如高效 太阳能电池、自旋光伏器件等.



图 8 (a) 自旋极化的 ScFe_{1-x}Cr_xO₃ 中光生载流子的弛 豫过程; (b) 光转换效率的自旋极化率^[22] Fig. 8. (a) Relaxation processes of photoexcited electrons in spin-polarized ScFe_{1-x}Cr_xO₃; (b) spin polarization of the photo conversion efficiency ^[22].

事实上,不仅铁电体的光伏效应可能受到自旋自由度的调控,它的其他非线性光学性质也被发现与自旋自由度相关.我们对具有四方对称性的BiFeO₃薄膜^[121,122]和块材^[88],Bi₂FeCrO₆^[114],BiCoO₃^[123]和PbVO₃^[124],甚至极性材料BiInO₃,BiAlO₃^[125]和Bi₂ZnTaO₃^[126]的非线性光学性质进行了计算.如图10所示,以BiFeO₃块材的计算为例,我们发现介电常数的实部和虚部能与实验符合得很好,说明第一性原理计算结果和可靠性^[88].进一步,第一性原理计算结果表明,这些材料的二次谐波产生(second harmonic generation, SHG)系数受到体系磁有序的影响,当磁有序从非铁磁序



图 9 (a) ScFe_{1-x}Cr_xO₃ 三明治结构作为光伏器件的示意图; (b) 铁电极化反转导致静电势的改变; (c) *J-V* 曲线; (d) PCE 随厚度的变化 ^[22]

Fig. 9. (a) Illustration of generation and separation of photo-induced spinpolarized carriers in a $ScFe_{1-x}Cr_xO_3$ -based sandwich structure. (b) Potential profile for $ScFe_{1-x}Cr_xO_{33}$ (here, x = 1/2), with the ferroelectric polarization pointing to the right-hand-side electrode. The dotted line shows the situation without ferroelectric polarization. (c) Current-voltage relationship of this sandwich structure with 100-nm-thick $ScFe_{1/2}Cr_{1/2}O_3$. The shaded area is the maximum power output. (d) PCE as a function of the thickness of $ScFe_{1-x}Cr_xO_3$ ($1/6 \le x \le 5/6$). Here, SFCO is for $ScFe_{1-x}Cr_xO_3$, SRO is for $SrRuO_3$, RP and LP are for the ferroelectric polarization pointing to the right and the left, respectively ^[22].



图 10 计算得到的 BiFeO₃ 块材实部和虚部, 计算结果 (红色实线) 与实验数据 (蓝色圆点) 符合较好 ^[88]



转变至铁磁序时, SHG系数明显增强, 这表明可以 利用磁场对它们的非线性光学性质进行调控, 预示 着多铁性材料光、磁和电的多功能性. 归根结底, 自 旋自由度对多铁性材料非线性光学性质的调控起 源于磁电序参量间的耦合作用. 以BiFeO₃为例, 其 铁电性主要来源于 A 位 Bi 离子的孤对电子, 而铁 磁性则主要由 B 位 Fe 离子的贡献. 显然, 铁电性和 铁磁性具有截然不同的物理起源, 毫无疑问, 这意 味着在 BiFeO₃ 中磁电耦合效应较弱. 但即使在基 态时电极化和磁化强度之间的耦合非常小, 在光频 段磁电耦合作用却变得十分重要, 导致多铁性材料 可能具有非常有趣的磁电线性和非线性光学性质.

7 结 论

铁电光伏效应因为其重要的应用前景和丰富 的物理内涵受到国内外研究者的广泛关注.目前, 研究者已经对铁电光伏效应的多种机制有比较深入的认识,找到了提高光伏效应的途径,探索具有高光电转换效率的新材料,并积极地通过引入新的自由度,实现铁电光伏器件的多功能性.但是,要将铁电光伏效应应用于实际的太阳能器件,还有很多的问题亟需解决.例如,如何区分多种机制对铁电光伏效应的贡献仍然比较困难,这无疑为准确、有效地提高光电转换效率带来不小的难度.如何利用能带工程原理结合薄膜制备技术,搜寻能隙较小、厚度较薄但铁电性优良的铁电体,实现较高的光电能量转换效率;如何更加深入地理解新的自由度(自旋自由度)在光生载流子的产生、输运和复合等过程中所扮演的角色及其对光伏效应的影响,这将帮助我们实现和开拓铁电光伏器件光敏感的多功能性.这些都是值得进一步研究的问题.

参考文献

- [1] Green M A, Bremner S P 2017 Nat. Mater. 16 23
- [2] Chapin D M, Fuller C S, Pearson G L A 1954 J. Appl. Phys. 25 676
- [3] Shockley W, Queisser H J 1961 J. Appl. Phys. 32 510
- [4] Lopez N, Reichertz L A, Yu K M 2011 Phys. Rev. Lett. 106 028701
- [5] Jackson E D 1958 Trans Conf. Use Solar Energy 5 122
- [6] Green M A, Keevers M J, Thomas I, Lasich J B, Emery K 2015 Prog. Photovolt. 23 685
- [7] Fridkin V M 1979 Photoferroelectrics (Berlin: Springer-Verlag)
- [8] King-Smith R D, Vanderbilt D 1993 Phys. Rev. B 47 1651
- [9] Seidel J, Eng L M 2014 Curr. Appl. Phys. 14 1083
- [10] Bulter K T, Frost J M, Walsh A 2015 Energy Environ. Sci. 8 838
- [11] Hu Z, Tian M, Nysten B, Jonas A M 2009 Nat. Mater. 8 62
- [12] Scott J F 2007 Science 315 954
- [13] Garcia V, Bibes M 2012 Nature 483 279
- [14] Lee D, Yang S M, Kim T H, Jeon B C, Kim Y S, Yoon J G, Lee H N, Baek S H, Eom C B, Noh T W 2012 Adv. Mater. 24 402
- [15] Dong S, Liu J M, Cheong S W, Ren Z 2015 Adv. Phys.
 64 519
- [16] Garcia V, Bibes M, Bocher L, Valencia S, Kronast F, Crassous A, Moya X, Enouz-Vedrenne S, Gloter A, Imhoff D, Deranlot C, Mathur N D, Fusil S, Bouzehouane K, Barthlmy A 2010 Science 327 1106
- [17] Ramesh R 2010 Nat. Mater. 9 380
- [18] Meyerheim H L, Klimenta F, Ernst A, Mohseni K, Ostanin S, Fechner M, Parihar S, Maznichenko I V, Mertig I, Kirschner J 2011 Phys. Rev. Lett. 106 087203

- [19] Cai T Y, Ju S, Sun H, Li Z Y 2008 Prog. Phys. 1 50 (in Chinese) [蔡田怡, 雎胜, 孙华, 李振亚 2008 物理学进展 1 50]
- [20] Weng Y K, Lin L F, Dagotto E, Dong S 2016 Phys. Rev. Lett. 117 037601
- [21] Cai T Y, Ju S, Lee J, Sai N, Demkov A A, Niu Q, Li Z
 Y, Shi J R, Wang E G 2009 *Phys. Rev. B* 80 140415
- [22] Cai T Y, Liu S C, Ju S, Liu C Y, Guo G Y 2017 Phys. Rev. Appl. 8 034034
- [23] Yuan Y, Xiao Z, Yang B, Huang J 2014 J. Mater. Chem. A 2 6027
- [24] Tan L Z, Zheng F, Young S M, Wang F, Liu S, Rappe A M 2016 npj Comput. Mater. 2 16026
- [25] Yang S Y, Seidel J, Byrnes S J, Shafer P, Yang C H, Rossell M D, Yu P, Chu Y H, Scott J F, Ager III J W, Martin L W, Ramesh R 2010 Nat. Nanotechnol. 5 143
- [26] Young S M, Rappe A M 2012 Phys. Rev. Lett. 109 116601
- [27] Grinberg I, West D V, Torres M, Gou G, Stein D M,
 Wu L, Chen G, Gallo E M, Akbashev A R, Davies P K,
 Spanier J E, Rappe A M 2013 Nature 503 509
- [28] Alexe M, Hesse D 2011 Nat. Commun. 2 256
- [29] Bhatnagar A, Chaudhuri A R, Kim Y H, Hesse D, Alexe M 2013 Nat. Commun. 4 2835
- [30] Kojima A, Teshima K, Shirai Y, Miyasaka T 2009 J. Am. Chem. Soc. 131 6050
- [31] Lee M M, Teuscher J, Miyasaka T, Murakami T N, Snaith H J 2012 Science 338 643
- [32] Burschka J, Pellet N, Moon S J, Humphry-Baker R, GaoP, Nazeeruddin M K, Grätzel M 2013 Nature 499 316
- [33] Heo J H, Im S H, Noh J H, Mandal T N, Lim C S, Chang J A, Lee Y H, Kim H J, Sarkar A, Nazeeruddin M K 2013 Nat. Photon. 7 486
- [34] Park N G 2013 J. Phys. Chem. Lett. 4 2423
- [35] Bass K K, McAnally R E, Zhou S, Djurovich P I, Thompson M E, Melot B C 2014 Chem. Commun. 50 15819
- [36] Bhachu D, Scanlon D, Saban E, Bronstein H, Parkin I, Carmalt C, Palgrave R 2015 J. Mater. Chem. A 3 9071
- [37] Zenkevich A, Matveyev Y, Maksimova K, Gaynutdinov R, Tolstikhina A, Fridkin V M 2014 *Phys. Rev. B* 90 161409
- [38] Sturman B S I, Fridkin V M 1992 Photovoltaic and Photorefractive Effects in Noncentrosymmetric Materials (Philadelphia: Gordon and Breach)
- [39] Fridkin V M, Popov B N 1978 Sov. Phys. Usp. 21 981V
- [40] Koch W T H, Munser R, Ruppel W, Wurfel P 1975 Solid State Commun. 17 847
- [41] Chynoweth A G 1956 Phys. Rev. 102 705
- [42] Belinicher V I, Sturman B I 1980 Phys.-Usp. 23 199
- [43] Lines M E, Glass A M 1977 Principles and Applications of Ferroelectrics and Related Materials (Oxford: Clarendon Press)
- [44] Fridkin V M 2012 Applications of Ferroelectrics Held Jointly with 2012 European Conference on the Applications of Polar Dielectrics and 2012 International Symp Piezoresponse Force Microscopy and Nanoscale Phenomena in Polar Materials (ISAF/ECAPD/PFM), Aveiro, Portugal, July 9–13, 2012, pp1, 2

- [45] Dresselhaus G 1955 *Phys. Rev.* **100** 580
- [46] Even J, Pedesseau L, Jancu J M, Katan C 2013 J. Phys. Chem. Lett. 4 2999
- [47] Brivio F, Butler K T, Walsh A, van Schilfgaarde M 2014 Phys. Rev. B 89 155204
- [48] Auston D H, Glass A M, Ballman A A 1972 Phys. Rev. Lett. 28 897
- [49] Glass A M, von der Linde D, Negran T J 1974 Appl. Phys. Lett. 25 233
- [50] Somma C, Reimann K, Flytzanis C, Elsaesser T, Woerner M 2014 Phys. Rev. Lett. 112 146602
- [51] Ji W, Yao K, Liang Y C 2010 Adv. Mater. 22 1763
- [52] Bieler M, Pierz K, Siegner U, Dawson P 2007 *Phys. Rev.* B 76 161304
- [53] Ogden T R, Gookin D M 1984 Appl. Phys. Lett. 45 995
- [54] Nakamura M, Kagawa F, Tanigaki T, Park H S, Matsuda T, Shindo D, Tokura Y, Kawasaki M 2016 *Phys. Rev. Lett.* **116** 156801
- [55] von Baltz R, Kraut W 1981 Phys. Rev. B 23 5590
- [56] Král P 2000 J. Phys.: Condens. Matter 12 4851
- [57] Sipe J E, Shkrebtii A I 2000 Phys. Rev. B 61 5337
- [58] Nastos F, Sipe J E 2010 Phys. Rev. B 82 235204
- [59] Young S M, Zheng F, Rappe A M 2012 Phys. Rev. Lett. 109 236601
- [60] Young S M, Zheng F, Rappe A M 2013 Phys. Rev. Lett. 110 057201
- [61] Tan L Z, Rappe A M 2016 Phys. Rev. Lett. 116 237402
- [62] Wang F, Young S M, Zheng F 2016 Nat. Commun. 7 10419
- [63] Starkiewicz J, Sosnowski L, Simpson O 1946 Nature 158 28
- [64] Johnson H R, Williams R H, Mee C H B 1975 J. Phys.
 D: Appl. Phys. 8 1530
- [65] Goldstein B, Pensak L 1959 J. Appl. Phys. 30 155
- [66] Uspenskii M D, Ivanova N G, Malkis I E 1968 Semiconductors 1 1059
- [67] Qin M, Yao K, Liang Y C 2009 J. Appl. Phys. 105 061624
- [68] Ichiki M, Furue H 2006 Proc. SPIE 6035 60350P
- [69] Xu J, Cao D W, Fang L, Shen M R 2009 J. Appl. Phys. 106 113705
- [70] Cao D W, Xu J, Fang L, Shen M R 2010 Appl. Phys. Lett. 96 192101
- [71] Qin M, Yao K, Liang Y C 2009 Appl. Phys. Lett. 95 022912
- [72] Yang S Y, Martin L W, Byrens S J 2009 Appl. Phys. Lett. 95 062909
- [73] Zheng F G, Xu J, Fang L, Shen M R 2008 Appl. Phys. Lett. 93 172101
- [74] Chen B, Li M, Liu Y W 2011 Nanotechnology 22 195201
- [75] Cao D W, Zhang H, Fang L, Shen M R 2010 Appl. Phys. Lett. 97 102104
- [76] Yi H, Choi T, Choi S, Oh Y S, Cheong S W 2011 Adv. Mater. 23 3403
- [77] Choi T, Lee S, Choi Y J, Kiryukhin V, Cheong S W 2009 Science 324 63
- [78] Kim D, Jo J, Kim Y 2005 Phys. Rev. Lett. 95 237602

- [79] Shvydaka D, Karpov V G 2008 Appl. Phys. Lett. 92 053507
- [80] Huang F, Liu X 2013 Appl. Phys. Lett. 102 103501
- [81] Zhang N, Yokota H, Glazer A, Ren Z, Keen D, Keeble D, Thomas P, Ye Z G 2014 Nat. Commun. 5 5231
- [82] Catlow C R A, Guo Z X, Miskufova M, Shevlin S A, Smith A G H, Sokol A A, Walsh A, Wilson D J, Woodley S M 2010 Philos. Trans. R. Soc. A 368 3379
- [83] Walsh A, Catlow C R A, Smith A G H, Sokol A A, Woodley S M 2011 Phys. Rev. B 83 220301
- [84] Nechache R, Harnagea C, Li S, Cardenas L, Huang W, Chakrabartty J, Rosei F 2015 Nat. Photon. 9 61
- [85] Zheng F, Xin Y, Huang W, Zhang J, Wang X, Shen M R, Dong W, Fang L, Bai Y, Shen X, Hao J 2014 J. Mater. Chem. A 2 1363
- [86] Wang F, Grinberg I, Rappe A M 2014 Phys. Rev. B 89 235105
- [87] Wang F, Grinberg I, Rappe A M 2014 Appl. Phys. Lett. 104 152903
- [88] Ju S, Cai T Y, Guo G Y 2009 J. Chem. Phys. 130 214708
- [89] Guo R, You L, Zhou Y, Lim Z S, Zou X, Chen L, Ramesh R, Wang J 2013 Nat. Commun. 4 1990
- [90] Hu W J, Wang Z, Yu W, Wu T 2016 Nat. Commun. 7 10808
- [91] Yang M, Luo Z, Kim D J, Alexe M 2017 Appl. Phys. Lett. 110 183902
- [92] Kim H S, Mora-Sero I, Gonzalez-Pedro V, Fabregat-Santiago F, Juarez-Perez E J, Park N G, Bisquert J 2013 *Nat. Commun.* 4 2242
- [93] Carnie M J, Charbonnaeu C, Davies M L, Troughton J, Watson T M, Wojciechowski K, Snaith H, Worsley D A 2013 Chem. Commun. 49 7893
- [94] Liu M, Johnston M B, Snaith H J 2013 Nature 501 395
- [95] Zhou H, Chen Q, Li G, Luo S, Song T B, Duan H S, Hong Z, You J, Liu Y, Yang Y 2014 Science 345 542
- [96] Noel N K, Stranks S D, Abate A, Wehrenfennig C, Guarnera S, Haghighirad A, Sadhanala A, Eperon G E, Pathak S K, Johnston M B, Petrozza A, Herz L, Snaith H 2014 Energy Environ. Sci. 7 3061
- [97] Umari P, Mosconi E, de Angelis F 2014 Sci. Rep. 4 4467
- [98] Brivio F, Walker A B, Walsh A 2013 APL Mater. 1 042111
- [99] Frost J M, Butler K T, Brivio F, Hendon C H, van Schilfgaarde M, Walsh A 2014 Nano Lett. 14 2584
- [100] Gottesman R, Haltzi E, Gouda L, Tirosh S, Bouhadana Y, Zaban A, Mosconi E, de Angelis F 2014 J. Phys. Chem. Lett. 5 2662
- [101] Mitzi D B, Wang S, Field C A, Chess C A, Guloy A M 1995 Science 267 1473
- [102] Calabrese J, Jones N, Harlow R, Herron N, Thorn D, Wang Y 1991 J. Am. Chem. Soc. 113 2328
- [103] Borriello I, Cantele G, Ninno D 2008 Phys. Rev. B 77 235214
- [104] Snaith H J, Abate A, Ball J M, Eperon G E, Leijtens T, Noel N K, Stranks S D, Wang J T W, Wojciechowski K, Zhang W 2014 J. Phys. Chem. Lett. 5 1511
- [105] Kutes Y, Ye L, Zhou Y, Pang S, Huey B D, Padture N P 2014 J. Phys. Chem. Lett. 5 3335

- [106] Zheng F, Takenaka H, Wang F, Koocher N Z, Rappe A M 2015 J. Phys. Chem. Lett. 6 31
- [107] Huang X, Paudel T R, Dong S, Tsymbal E Y 2015 *Phys. Rev. B* 92 125201
- [108] Inaguma Y, Yoshida M, Katsumata T 2008 J. Am. Chem. Soc. 130 6704
- [109] Inaguma Y, Aimi A, Shirako Y, Sakurai D, Mori D, Kojitani H, Akaogi M, Nakayama M 2014 J. Am. Chem. Soc. 136 2748
- [110] Inaguma Y, Tanaka K, Tsuchiya T, Mori D, Katsumata T, Ohba T, Hiraki K, Takahashi T, Saitoh H 2011 J. Am. Chem. Soc. 133 16920
- [111] Li M R, Adem U, McMitchell S R, Xu Z, Thomas C I, Warren J E, Schiffmann F 2012 J. Am. Chem. Soc. 134 3737
- [112] Li M R, Stephens P W, Retuerto M, Sarkar T, Grams C P, Hemberger J, Croft M C, Walker D, Greenblatt M 2014 J. Am. Chem. Soc. 136 8508
- [113] Baettig P, Spaldin N A 2005 Appl. Phys. Lett. 86 012505
- [114] Ju S, Guo G Y 2008 Appl. Phys. Lett. 92 202504

- [115] Pálová L, Chandra P, Rabe K M 2010 Phys. Rev. Lett. 104 037202
- [116] Diéguez O, Íñiguez J 2011 Phys. Rev. Lett. 107 057601
- [117] Wang P S, Ren W, Bellaiche L, Xiang H J 2015 Phys. Rev. Lett. 114 147204
- [118] Young S M, Zheng F, Rappe A M 2015 *Phys. Rev. Appl.* 4 054004
- [119] He J, Franchini C, Rondinelli J M 2016 Chem. Mater. 28 25
- [120] Stroppa A, Sante D D, Barone P, Bokdam M, Kresse G, Franchini C, Whangbo M H, Picozzi S 2014 Nat. Commun. 5 5900
- [121] Ju S, Cai T Y 2009 Appl. Phys. Lett. 95 112506
- [122] Ju S, Cai T Y 2009 Appl. Phys. Lett. 95 231906
- [123] Ju S, Cai T Y, Wei C I, Guo G Y 2009 Opt. Lett. 34 3860
- [124] Ju S, Cai T Y 2008 Appl. Phys. Lett. 93 251904
- [125] Ju S, Cai T Y 2009 Appl. Phys. Lett. 94 191908
- [126] Ju S, Guo G Y 2008 J. Chem. Phys. 129 194704

SPECIAL TOPIC — Multiferroicity: Physics, materials, and devices

Photovoltaic effect in ferroelectrics^{*}

Cai Tian-Yi^{\dagger} Ju Sheng^{\ddagger}

(School of Physical Science and Technology, Soochow University, Suzhou 215006, China)
 (Received 18 May 2018; revised manuscript received 13 June 2018)

Abstract

Ferroelectric oxides are attractive materials for constructing efficient solar cells. The mechanism includes the anomalous photovoltaic effect (APE) and the bulk photovoltaic effect (BPE). The BPE refers to the generation of a steady photocurrent and above-bandgap photovoltage in a single-phase homogeneous material lacking inversion symmetry. The mechanism of BPE is different from the typical p-n junction-based photovoltaic mechanism in heterogeneous materials. We survey the history, development and recent progress in understanding the mechanisms of BPE, with a focus on the shift current mechanism, an intrinsic BPE that is universal to all materials lacking inversion symmetry. We also review the important factors to the APE, i.e., the domain boundary, the Schottcky junction, and the depolarization field. The recent successful applications of inorganic and hybrid perovskite structured materials in solar cells emphasize that ferroelectric absorber layer and the solid state theory of polarization. In addition to discussing the implication of a ferroelectric absorber layer and the solid state theory of polarization, the design principles and prospect for high-efficiency ferroelectrics are expected to have prominent multi-functionality. With the introduction of the additional degree of freedom, some ferroelectrics, i.e., ScFe_xCr_{1-x}O₃ ($1/6 \leq x \leq 5/6$), can be a promising candidate for highly efficient solar cells and spin photovoltaic devices.

Keywords: ferroelectrics, photovoltaics, multiferroics, solar cells

PACS: 78.56.-a, 84.60.Jt, 77.84.-s, 75.85.+t

DOI: 10.7498/aps.67.20180979

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11374220, 11204193), the National Basic Research Program of China (Grant No. 2014CB920900), the Qinlan Project of Jiangsu Province, and the Dongwu Scholar Project of Soochow University.

 $[\]dagger\,$ Corresponding author. E-mail: caitianyi@suda.edu.cn

[‡] Corresponding author. E-mail: jusheng@suda.edu.cn